

КТ368АМ, БМ, ВМ
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

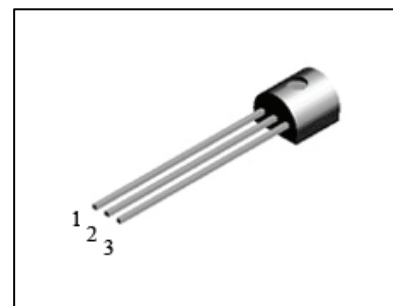
Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в усилительных в усилительных схемах аппаратуры широкого применения.

Номер технических условий

- аАО.365.025 ТУ / 02

Особенности

- Диапазон рабочих температур от - 60 до + 100 °С



Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	База
№3	Коллектор

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ368АМ,БМ, ВМ при $T_{\text{окр. среды}} = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мкА	$U_{кб}=15\text{В}, I_{э}=0$		0,5
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мкА	$U_{эб}=4\text{В}$		1,0
Статический коэффициент передачи тока КТ368АМ КТ368БМ КТ368ВМ	h_{21E}		$U_{кб}=1\text{В}, I_{э}=10\text{мА}$	50 50 100	450 450 450
Коэффициент шума для КТ368АМ	Кш	дБ	$U_{кб}=5\text{В}, I_{э}=10\text{мкА},$ $f=6 \cdot 10^7\text{ Гц},$ $R_{г}=75\text{ Ом}$	-	3,3
Граничное напряжение	$U_{кэо гр}$	В	$I_{э}=10\text{мА}, t_{и} \leq 500$ мкс, $Q \geq 100$	15	-
Напряжение насыщения база - эмиттер	$U_{бэ(нас)}$	В	$I_{к}=20\text{мА}, I_{б}=2,0\text{мА}$		0,9 - 1,35
Емкость коллекторного перехода	$C_{к}$	пФ	$U_{кб}=5\text{В}, f=10^7\text{ Гц}$	-	1,7
Емкость эмиттерного перехода	$C_{э}$	пФ	$U_{эб}=1\text{В}, f=10^7\text{ Гц}$	-	3
Постоянная времени цепи обратной связи	$\tau_{к}$	пс	$U_{кб}=5\text{В}, I_{э}=10\text{мА},$ $F=3 \cdot 10^7\text{ Гц}$	-	15

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ368АМ-ВМ

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение	Примечание
Напряжение коллектор-база	$U_{кб max}$	В	15	1
Импульсное напряжение коллектор-база	$U_{кб и max}$	В	20	1,2
Напряжение коллектор-эмиттер	$U_{кэг max}$	В	15	1,4
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер	$U_{кэг и max}$	В	20	1,2
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб max}$	В	4	1
Постоянный ток коллектора (эмиттера)	$I_{к (э) max}$	мА	30	1
Постоянный импульсный ток коллектора (эмиттера)	$I_{к (э) и max}$	мА	60	1,2
Рассеиваемая мощность коллектора при температуре окружающей среды: от - 60 до + 65 °С при температуре 100 °С	$P_{к max}$	мВт	225 130	- 3
Тепловое сопротивление транзистора переход-среда	$R_{т п-ср}$	°С / Вт	380	-
Температура перехода	$T_{п max}$	°С	150	-

Примечания к таблице 2:

1. Для всего диапазона рабочих температур
2. При длительности импульса не более 0,5 мс, скважности не менее 2.
3. В диапазоне температур от 65 до 100 °С мощность снижается по линейному закону.
4. Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при токе эмиттера 10 мА.